

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Chữ Mạnh Hưng

2. Ngày tháng năm sinh: 28/12/1984; Nam ☒; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Số nhà 10, Ngõ Đình Đại, Đường Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bru điện): Chữ Mạnh Hưng, Số nhà 10, Ngõ Đình Đại, Đường Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: 0988138085; Điện thoại di động: 0988138085;

E-mail: hung.chumanh@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2009 đến năm 2011: Học viên Cao học tại Trường Đại học Quốc gia Kyungpook

Từ năm 2011 đến năm 2014: Lâm Nghiê cứu sinh tại Trường Đại học Grenoble Alpes và Viện Nghiê cứu Synchrotron Châu Âu (ESRF)

Từ năm 2014 đến năm 2016: Nghiê cứu sau Tiến sĩ (Postdoc) tại Viện nghiê cứu Synchrotron SOLEIL

Từ năm 2016 đến năm 2020: Giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chức vụ: Hiện nay: Giảng viên; Trợ lý Khoa học Viện; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên; Trợ lý Khoa học Viện

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): không tham gia

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 04 tháng 07 năm 2008, ngành: Vật lý Kỹ Thuật, chuyên ngành: Vật liệu Điện tử

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS ngày 25 tháng 02 năm 2011, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu Điện tử

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc.

- Được cấp bằng TS ngày 07 tháng 04 năm 2015, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý của vật liệu/Khoa học vật liệu

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học)

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Vật liệu nano ô xít kim loại bán dẫn (nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc tính của vật liệu ô xít kim loại bán dẫn 1 nguyên, 2 nguyên với các cấu trúc nano khác nhau)
- Vật liệu dichalcogenides kim loại chuyển tiếp, kim loại quý (nghiên cứu chế tạo và đo đạc đặc tính của vật liệu)
- Nghiên cứu phát triển thế hệ cảm biến khí hoạt động ở nhiệt độ thấp/nhiệt độ phòng dựa trên các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano nhằm hướng tới ứng dụng trong các thiết bị cầm tay phân tích hơi thở, thực phẩm và quan trắc môi trường

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);

- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Bộ; 2 đề tài NCKH cấp Cơ sở;

- Đã công bố (số lượng) 84 bài báo KH, trong đó 52 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	2019
2	Đảng Viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	2019
3	Đảng Viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	2018
4	Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018"	Bộ Giáo dục và Đào tạo	2018

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Với nhiệm vụ của giảng viên, tôi luôn phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học trong giảng dạy, hướng dẫn (sinh viên thực tập tốt nghiệp, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh) và nghiên cứu khoa học tại Đơn vị. Tôi cũng luôn giữ gìn lối sống, phẩm chất đạo đức phù hợp với người giảng viên, luôn sẵn sàng và giúp đỡ các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và đồng nghiệp khi cần trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 3,1 năm.

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

--

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghệ ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1								
2								
3								
3 năm học cuối								
4	2017-2018		2	2			24	24/304/270
5	2018-2019	1	1	1	1		138	138/283/270
6	2019-2020	1	1			30	228	258/308/270

() - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.*

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☒:

- Học ĐH ☐; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☒ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Cộng hòa Pháp năm 2014

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Không

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đỗ Quang Đạt		X	X		09/2016 đến 04/2018	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	2018
2	Vy Anh Vương		X	X		03/2017 đến 10/2018	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	2018
3	Lê Thị Hồng		X	X		01/2018 đến 04/2019	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	2019

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Các cấu trúc nano ôxít kim loại bán dẫn ứng dụng cho cảm biến khí	CK	Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, năm 2019	8	VC	(Biên soạn một mình Chương 2 (từ trang 53 đến 98))	363/GCN-ĐH BK-ITIMS ngày 28/06/2019

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 1

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					

1	Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí công suất tiêu thụ thấp dựa trên hiệu ứng tự đốt nóng sử dụng mạng lưới dây nano ô xít kim loại	CN	103.02-2015.88, cấp Bộ	01/05/2016 đến 30/04/2018	(10/02/2018) / Kết quả Đạt
2	Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc tính của vật liệu 2D họ dichalcogenides kim loại chuyển tiếp MoS2	CN	T2017-TT-006, cấp Cơ sở	01/11/2017 đến 31/10/2018	(07/11/2018) / Kết quả Đạt
3	Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2S dựa trên vật liệu sợi nano ôxít kim loại SnO2	CN	T2018-PC-070, cấp Cơ sở	01/03/2019 đến 29/02/2020	(27/03/2020)/ Kết quả Đạt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Structural order in single Co-implanted ZnO nanowires	5	Có	Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science	Q2 - SCIE IF: 1.606	3	211, 483	2014

2	Local lattice distortions in single Co-implanted ZnO nanowires	5	Có	Applied Physics Letters	Q1 - SCIE IF: 3.521	7	103, 141911	2013
3	Intense intra-3d luminescence and waveguide properties of single Co-doped ZnO nanowires	9	Không	Physica Status Solidi - Rapid Research Letters	Q1 - SCIE IF: 3.729	5	7, 886	2013
4	Radial composition of single InGaN nanowires: A combined study by EDX, Raman spectroscopy, and X-ray diffraction	9	Không	Physica Status Solidi - Rapid Research Letters	Q1 - SCIE IF: 3.729	2	7, 864	2013
5	Synchrotron nanoimaging of single In-rich InGaN nanowires	6	Không	Journal of Applied Physics	Q2 - SCIE IF: 2.328	11	113, 136511	2013
6	Low temperature growth and optical properties of ZnO nanowires using an aqueous solution method	6	Có	Journal of Nanoscience and Nanotechnology	- SCIE IF: 1.093		12, 1415	2012

7	Characterization of single semiconductor nanowires by synchrotron radiation nanoprobe	6	Không	Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		9, 639	2012
8	Nano-X-ray absorption spectroscopy of single Co-implanted ZnO nanowires	5	Không	Nano Letters	Q1 - SCIE IF: 12.279	55	11, 5322	2011
9	Synchrotron fluorescence nanoimaging of a single Co-implanted ZnO nanowire	7	Có	Physica Status Solidi - Rapid Research Letters	Q1 - SCIE IF: 3.729	9	5, 283	2011
10	UV photoresponse of ag-doped multiple zno nanowires	5	Có	Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics	- SCIE IF: 0.472	2	6, 244	2011
11	Catalyst-free patterned growth of well-aligned ZnO nanowires on ITO substrates using an aqueous solution method and lithography process	8	Có	Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics	- SCIE IF: 0.472	3	5, 186	2010

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

12	Controlled Growth of Vertically Oriented Trilayer MoS ₂ Nanoflakes for Room-Temperature NO ₂ Gas Sensor Applications	7	Có	Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science	Q2 - SCIE IF: 1.606		217, 1-8	2020
13	Enhanced H ₂ S gas-sensing performance of α -Fe ₂ O ₃ nanofibers by optimizing process conditions and loading with reduced graphene oxide	10	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - SCIE IF: 4.175		826, 154169	2020
14	Facile synthesis of ultrafine rGO/WO ₃ nanowire nanocomposites for highly sensitive toxic NH ₃ gas sensors	7	Có	Materials Research Bulletin	Q1 - SCIE IF: 3.355		125, 110810	2020
15	Controlled synthesis of ultrathin MoS ₂ nanoflowers for highly enhanced NO ₂ sensing at room temperature	7	Có	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	1	10, 12759	2020

16	One-step fabrication of SnO ₂ porous nanofiber gas sensors for sub-ppm H ₂ S detection	6	Có	Sensors and Actuators, A: Physical	Q1 - SCIE IF: 2.739	4	303, 111722	2020
17	Realization of a portable H ₂ S sensing instrument based on SnO ₂ nanowires	7	Không	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.36		5, 40	2020
18	VOC gas sensor based on hollow cubic assembled nanocrystal Zn ₂ SnO ₄ for breath analysis	7	Có	Sensors and Actuators, A: Physical	Q1 - SCIE IF: 2.739	1	302, 111834	2020
19	Effective monitoring and classification of hydrogen and ammonia gases with a bilayer Pt/SnO ₂ thin film sensor	6	Không	International Journal of Hydrogen Energy	Q1 - SCIE IF: 4.084	1	45, 2418	2020
20	Dip-coating decoration of Ag ₂ O nanoparticles on SnO ₂ nanowires for high-performance H ₂ S gas sensors	6	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049		10, 17713	2020

21	Prototype edge-grown nanowire sensor array for the real-time monitoring and classification of multiple gases	7	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.36		,	2020
22	A facile synthesis of ruthenium/reduced graphene oxide nanocomposite for effective electrochemical applications	9	Không	Solar Energy	Q1 - SCIE IF: 4.374	3	191, 420	2019
23	Effective design and fabrication of low-power-consumption self-heated SnO2 nanowire sensors for reducing gases	6	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	8	295, 144	2019
24	Self-heated Ag-decorated SnO2 nanowires with low power consumption used as a predictive virtual multisensor for H2S-selective sensing	7	Không	Analytica Chimica Acta	Q1 - SCIE IF: 5.256	4	1069, 108	2019

25	Excellent detection of H ₂ S gas at ppb concentrations using ZnFe ₂ O ₄ nanofibers loaded with reduced graphene oxide	6	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	23	282, 876	2019
26	New design of ZnO nanorod- And nanowire-based NO ₂ room-temperature sensors prepared by hydrothermal method	7	Không	Journal of Nanomaterials	Q2 - SCIE IF: 2.233	4	2019, 1-9	2019
27	An effective H ₂ S sensor based on SnO ₂ nanowires decorated with NiO nanoparticles by electron beam evaporation	8	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	5	9, 13887	2019
28	Facile Hydrothermal Synthesis of Two-Dimensional Porous ZnO Nanosheets for Highly Sensitive Ethanol Sensor	8	Có	Journal of Nanomaterials	Q2 - SCIE IF: 2.233	1	2019, 1-7	2019

29	SO ₂ and H ₂ S Sensing Properties of Hydrothermally Synthesized CuO Nanoplates	6	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.676	8	47, 7170	2018
30	Nanoporous and crystal evolution in nickel oxide nanosheets for enhanced gas-sensing performance	4	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	20	273, 784	2018
31	Facile on-chip electrospinning of ZnFe ₂ O ₄ nanofiber sensors with excellent sensing performance to H ₂ S down ppb level	5	Có	Journal of Hazardous Materials	Q1 - SCIE IF: 7.65	22	360, 6	2018
32	Comparative effects of synthesis parameters on the NO ₂ gas-sensing performance of on-chip grown ZnO and Zn ₂ SnO ₄ nanowire sensors	5	Có	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - SCIE IF: 4.175	11	765, 1237	2018

33	Simple post-synthesis of mesoporous p-type Co ₃ O ₄ nanochains for enhanced H ₂ S gas sensing performance	7	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	20	270, 158	2018
34	Urea mediated synthesis of Ni(OH) ₂ nanowires and their conversion into NiO nanostructure for hydrogen gas-sensing application	5	Không	International Journal of Hydrogen Energy	Q1 - SCIE IF: 4.229	20	43, 9446	2018
35	Ultrasensitive NO ₂ gas sensors using hybrid heterojunctions of multi-walled carbon nanotubes and on-chip grown SnO ₂ nanowires	5	Không	Applied Physics Letters	Q1 - SCIE IF: 3.521	4	112, 153110	2018
36	Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for highly selective NH ₃ gas sensor	7	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - SCIE IF: 4.175	13	735, 787	2018

37	Fe ₂ O ₃ nanoporous network fabricated from Fe ₃ O ₄ /reduced graphene oxide for high- performance ethanol gas sensor	8	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	51	255, 3275	2018
38	A comparative study on the electrochemical properties of nanoporous nickel oxide nanowires and nanosheets prepared by a hydrothermal method	6	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	9	8, 19449	2018
39	Ultralow power consumption gas sensor based on a self-heated nanojunction of SnO ₂ nanowires	7	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	5	8, 36323	2018
40	C ₂ H ₅ OH and NO ₂ sensing properties of ZnO nanostructures: Correlation between crystal size, defect level and sensing performance	7	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	20	8, 5629	2018

41	Bilayer SnO ₂ -WO ₃ nanofilms for enhanced NH ₃ gas sensing performance	6	Không	Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology	Q1 - SCIE IF: 3.507	21	224, 163	2017
42	On-chip growth of semiconductor metal oxide nanowires for gas sensors: A review	3	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.36	38	2, 263	2017
43	Ethanol-Sensing Characteristics of Nanostructured ZnO: Nanorods, Nanowires, and Porous Nanoparticles	6	Không	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.676	17	46, 3406	2017
44	Evaluation of Alternative Atomistic Models for the Incipient Growth of ZnO by Atomic Layer Deposition	15	Có	Journal of Electronic Materials	Q2 - SCIE IF: 1.676	3	46, 3512	2017
45	Novel Self-Heated Gas Sensors Using on-Chip Networked Nanowires with Ultralow Power Consumption	7	Có	ACS Applied Materials and Interfaces	Q1 - SCIE IF: 8.456	16	9, 3512	2017

46	Low-temperature prototype hydrogen sensors using Pd-decorated SnO ₂ nanowires for exhaled breath applications	7	Có	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	32	253, 156	2017
47	Superior enhancement of NO ₂ gas response using n-p-n transition of carbon nanotubes/SnO ₂ nanowires heterojunctions	7	Không	Sensors and Actuators, B: Chemical	Q1 - SCIE IF: 6.393	24	238, 1120	2017
48	On-chip growth of single phase Zn ₂ SnO ₄ nanowires by thermal evaporation method for gas sensor application	8	Không	Journal of Alloys and Compounds	Q1 - SCIE IF: 4.175	11	708, 470	2017
49	SIRIUS: A new beamline for in situ X-ray diffraction and spectroscopy studies of advanced materials and nanostructures at the SOLEIL Synchrotron	6	Không	Thin Solid Films	Q2 - SCIE IF: 1.888	14	617, 48	2016

50	An atomistic view of the incipient growth of zinc oxide nanolayers	14	Có	ACS Crystal Growth and Design	Q1 - SCIE IF: 4.153	7	16, 5339	2016
51	Ferromagnetism and Conductivity in Hydrogen Irradiated Co-Doped ZnO Thin Films	12	Không	ACS Applied Materials and Interfaces	Q1 - SCIE IF: 8.456	12	8, 12925	2016
52	Synthesis and gas-sensing characteristics of α -Fe ₂ O ₃ hollow balls	6	Có	Journal of Science: Advanced Materials and Devices	Q1 - SCIE IF: 3.36	21	1, 45	2016
53	Evolution of Crystal Structure during the Initial Stages of ZnO Atomic Layer Deposition	18	Không	Chemistry of Materials	Q1 - SCIE IF: 10.159	18	28, 592	2016
54	Nanoporous ZnO nanostructure synthesis by a facile method for superior sensitivity ethanol sensor applications	8	Không	RSC Advances	Q1 - SCIE IF: 3.049	12	6, 64215	2016

55	Crossed Ga ₂ O ₃ /SnO ₂ multiwire architecture: A local structure study with nanometer resolution	8	Không	Nano Letters	Q1 - SCIE IF: 12.279	26	14, 5479	2014
56	Nano-X-ray diffraction study of single Co-implanted ZnO nanowires	5	Có	Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science	Q2 - SCIE IF: 1.606	3	211, 2523	2014
57	Synthesis Of Octahedron Zn ₂ SnO ₄ By Hydrothermal Method For High Performance Ethanol Sensor	6	Có	Vietnam Journal of Science and Technology			58, 181	2020
58	Gas Sensor Array Based on Tin Oxide Nano Structure for Volatile Organic Compounds Detection	6	Không	Vietnam Journal of Science and Technology			58, 189	2020
59	NO ₂ gas sensing characteristics of SnO ₂ nanofiber-based sensors	3	Có	Journal of Science & Technology			142, 023	2020

60	Facile Synthesis and Electrical Characteristics of n-SnO ₂ /p-NiO Nanowire Heterojunctions	2	Có	Communications in Physics			29, 77	2019
61	Impedance Spectroscopy Analysis of SnO ₂ Nanowires/Carbon Nanotubes Heterojunctions	4	Không	Journal of Science & Technology			133, 058	2019
62	Controlled Synthesis and Characterization of rGO Materials by Hydrothermal Method	4	Không	Journal of Science & Technology			135, 056	2019
63	Hydrothermal Synthesis of Zn ₂ SnO ₄ Nanoparticles for Ethanol sensor	4	Có	Journal of Science & Technology			135, 067	2019
64	SnO ₂ /Pt (40nm/10nm) Thin Films Sensitized for Enhanced H ₂ Gas Sensing	5	Có	Journal of Science & Technology			138, 051	2019

65	Effect of Hydrothermal Temperature on the Morphology and Structure of Synthesized MoS ₂ Nanostructures	7	Có	Journal of Science & Technology			138, 061	2019
66	H ₂ S Gas Sensing Characteristics of ZnO Nanofibers Fabricated by Electrospinning	3	Có	Kỷ yếu HN Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 11 (SPMS2019)			2, 650	2019
67	Synthesis Pd-CuO Nanoplates for Enhancement of H ₂ Gas-Sensing Performance	4	Có	Kỷ yếu HN Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 11 (SPMS2019)			2, 747	2019
68	Hydrogen Sensor Operating at Low Temperature Using SnO ₂ /Pt Thin Films	9	Không	Kỷ yếu HN Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 11 (SPMS2019)			2, 822	2019
69	Co ₃ O ₄ nanofibers synthesized via electrospinning for toxic gas detection	2	Có	Proceedings: the 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2019)			1, 210	2019

70	Hydrothermal synthesis and CO gas sensing properties of In ₂ O ₃ nanorods	5	Không	Proceedings: the 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2019)			1, 222	2019
71	Synthesis and NH ₃ gas sensing characteristics of rGO/WO ₃ nanocomposite	6	Không	Journal of Science & Technology			124, 068	2018
72	Direct Synthesis of MoS ₂ Nanodots by Chemical Vapor Deposition	2	Có	Communications in Physics			28, 379	2018
73	Synthesis and characterization of MoS ₂ /rGO nanocomposites for supercapacitor applications	5	Không	Proceedings: The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018)			1, 404	2018
74	Synthesis and characterization of MoS ₂ nanostructures	3	Có	Proceedings: The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018)			1, 421	2018

75	In-Situ Fabrication of SnO ₂ Nanowires/Carbon Nanotubes Heterojunctions Based NO ₂ Gas Sensors	4	Không	Journal of Science & Technology			118, 036	2017
76	On-Chip ZnO Nanofibers Prepared by Electrospinning Method for NO ₂ Gas Detection	6	Có	Communications in Physics			27, 317	2017
77	Tăng Cường Tính Nhạy Khí NO ₂ Tại Nhiệt Độ Phòng Cửa Dây Nano Cấu Trúc SnO ₂ –Lõi/ ZnO–Vỏ	5	Không	Kỷ yếu HN Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017)			1, 369	2017
78	Enhanced Hydrogen Sensitivity of Self- Heating Sensor Using SnO ₂ Nanowires Network by Pd Catalyst	4	Không	Kỷ yếu HN Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017)			1, 376	2017
79	Enhancement of Ammonia gas sensor based on SnO ₂ /Pd bi-layer thin film	6	Không	Proceedings: The 12th Asian Conference on Chemical Sensor (ACCS2017)			1, 331	2017

80	Investigating NO ₂ sensing capabilities of the electrospun α -Fe ₂ O ₃ nanofibers-based sensors	4	Không	Proceedings: The 12th Asian Conference on Chemical Sensor (ACCS2017)			1, 341	2017
81	H ₂ S Sensing Characteristics of Self-heated Ag-coated SnO ₂ nanowires	5	Không	Proceedings: The 12th Asian Conference on Chemical Sensor (ACCS2017)			1, 350	2017
82	Effects of Ultraviolet illumination on NO ₂ gas-sensing characteristics of SnO ₂ nanowires sensor	9	Không	Proceedings: the 3th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2016)			1, 7	2016
83	Effect of thermal treatment on the ethanol sensing properties of nanostructured ZnO	10	Không	Proceedings: the 3th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2016)			1, 366	2016
84	On-chip grown SnO ₂ nanowire sensors on glass substrate for hydrogen monitoring	4	Không	Proceedings: the 3th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2016)			1, 371	2016

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 16

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS. 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải

pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Cảm biến khí NH ₃ dạng màng mỏng SnO ₂ /WO ₃ và quy trình chế tạo	Cục sở hữu trí tuệ	23/12/2019	Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đức Hòa, Chủ Mạnh Hưng	5

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 1

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Không có				

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
1	Chương trình nghiên cứu phát triển các vật liệu tiên tiến ứng dụng trong công nghiệp điện tử, y sinh, năng lượng và xử lý môi trường	Tham gia	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 2 năm 11 tháng

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu): (năm học 2017-2018/ số giờ thiếu: 111)

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (U'V chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (U'V chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (U'V chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (U'V chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc U'V không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc U'V không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội. , ngày 29 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)